




| | | |
|---|--|---|
|  | <h2 style="color: orange;">IPS118N10N G</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | IPS118N10N G |
|  | Hersteller / Marke: | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 100V 75A TO251-3 |
| Datenblätter: |  IPS118N10N G.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IPS118N10N G |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 75A TO251-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 83µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TO251-3 |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 11.8 mOhm @ 75A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 125W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-251-3 Stub Leads, IPak |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4320pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 65nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 75A (Tc) |

IPS118N10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPS118N10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPS118N10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPS118N10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>IPS10N03LA G Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A IPAK</p> |  <p>IPS110N12N3GBKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 75A TO251-3</p> |  <p>IPS12CN10L INFNEON IPS12CN10L INFNEON</p> |  <p>IPS10N03LA INFNEON INFNEO to251</p> |
|  <p>IPS116D PHL IPS116D PHL</p> |  <p>IPS12CN10LGBKMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 69A TO251-3-11</p> |  <p>IPS110N12N3G I I PG-TO252-</p> |  <p>IPS12CN10LG INFNEON IPS12CN10LG INFNEON</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| IPS118N10N G International Rectifier (Infineon Technologies) | IPS118N10N G Datenblatt | IPS118N10N G-Datenblätter | IPS118N10N G PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPS118N10N G |
| IPS118N10N G Electronic | IPS118N10N G-Komponenten | IPS118N10N G-Verteiler | IPS118N10N G-Bild | IPS118N10N G-Teil |
| IPS118N10N G Preis | IPS118N10N G Hersteller | IPS118N10N G Bild | IPS118N10N G Aktie | IPS118N10N G Inventar |
| IPS118N10N G Neu | IPS118N10N G Original | IPS118N10N G garantiert | IPS118N10N G RFQ | IPS118N10N G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited